

# Une méthode numérique sur grille cartésienne pour la tomographie par impédance électrique.

Niami NASR sous la direction de Jérémie DARDÉ (IMT) et Lisl WEYNANS (IMB/INRIA).

Institut de mathématiques de Bordeaux et CARMEN INRIA

June 24, 2021

# Tomographie par Impédance Electrique (EIT)

## Définition



Figure: *Reconstruction non-invasive de conductivités à partir de mesures électriques sur le bord du domaine.* From *Electrical Impedance Tomography: The realisation of regional ventilation monitoring* 2nd edition Eckhard Teschner Michael Imhoff Steffen Leonhardt.

# EIT: modélisation du problème direct

"Complete electrode model": ajout impédance de contact  $z_m$ .

Trouver  $u \in H^1(\Omega)$  et  $U \in \mathbb{R}_{\diamond}^M$  tels que

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0 & \text{dans } \Omega \\ u + z_m \sigma \partial_{\nu} u = U_m & \text{sur } E_m, \\ \sigma \partial_{\nu} u = 0 & \text{sur } \partial\Omega \setminus \bar{E}, \\ \int_{E_m} \sigma \partial_{\nu} u \, ds = I_m. \end{cases}$$

avec  $E_m$  électrode  $m$ ,  $z_m$  impédance associée,  $I \in \mathbb{R}_{\diamond}^M$  courant et

$$\mathbb{R}_{\diamond}^M = \left\{ I \in \mathbb{R}^M, \sum_{k=1}^M I_k = 0 \right\},$$

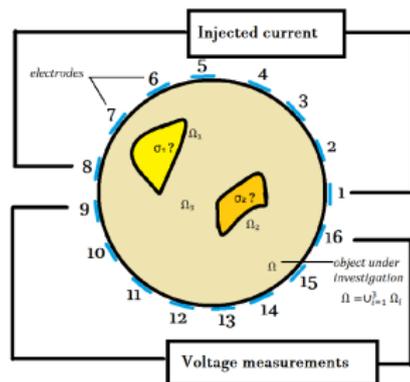


Figure: Image tirée de la thèse A. Velasco

# Tomographie par Impédance Electrique (EIT)

## Définition

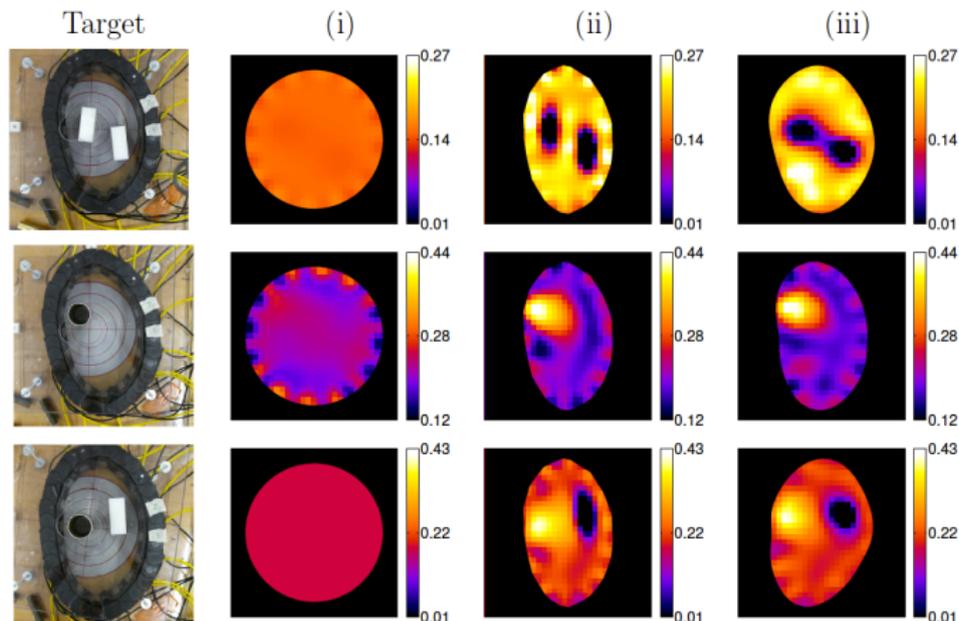
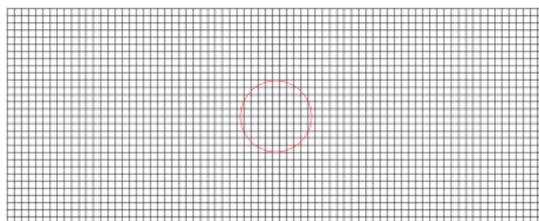


Figure: Dardé et al, SIAM J. Imaging Sci. 2013

# Discrétisation dans des géométries complexes



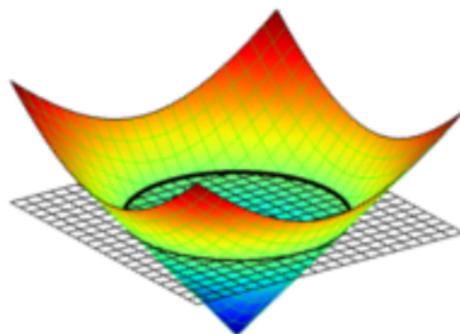
## Maillage cartésien:

- Très facile à créer et manipuler,
- Facilement découppable pour faire du calcul parallèle,
- Les schémas usuels ne conviennent plus, car dans une même maille peuvent exister deux états aux propriétés différentes

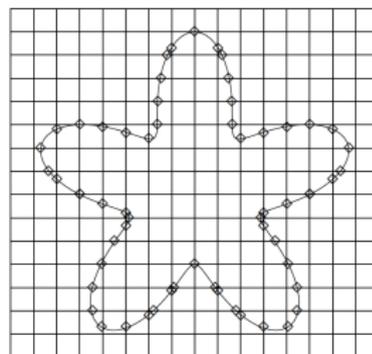
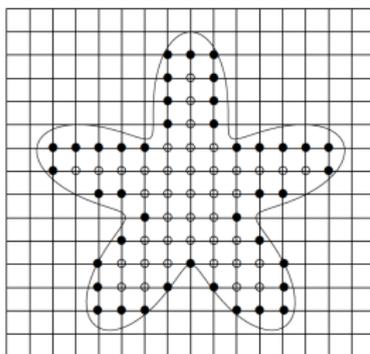
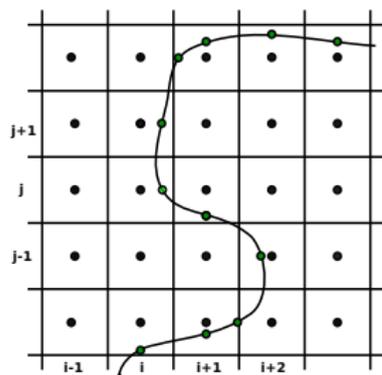
⇒ Développement de méthodes de "Frontières immergées"

## Description de l'interface

- 1 Représentation implicite:  
Interface = iso-ligne zéro d'une fonction régulière  $\phi$ .
- 2 Pratique avec une discrétisation sur grilles cartésiennes
- 3 Traitement aisé de géométries complexes et changements de topologie



# Stratégie de discrétisation

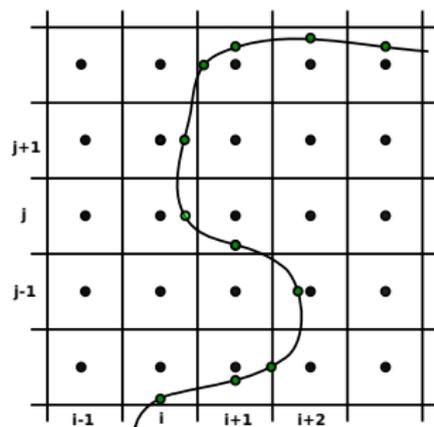


- Création d'inconnues supplémentaires sur l'interface
  - utilisées pour discrétiser l'opérateur elliptique sur le bord du domaine
  - obtenues par une discrétisation des conditions aux limites sur les flux
- Deux types de point de grille :
  - Point régulier (point loin de l'interface)
  - Point irrégulier (point de grille proche de l'interface)

# Méthode numérique en proche

## Discretisation de l'opérateur élliptique

$$\begin{aligned} -\left(\nabla \cdot (\sigma \nabla u)\right)_{i,j}^h &= -\left(\sigma_{i+1/2,j} \frac{u_N^h - u_{ij}^h}{x_N - x_i} - \sigma_{i-1/2,j} \frac{u_{ij}^h - u_S^h}{x_i - x_S}\right) \frac{1}{h} \\ &\quad -\left(\sigma_{i,j+1/2} \frac{u_E^h - u_{ij}^h}{y_E - y_j} - \sigma_{i,j-1/2} \frac{u_{ij}^h - u_W^h}{y_j - y_W}\right) \frac{1}{h}. \end{aligned}$$



# Méthode numérique en proche

## Discrétisation de la condition au bord

On discrétise la condition au bord à chaque point du bord  $I_{i+1/2,j}$  :

$$\sigma(\partial_n u)_{i+1/2,j}^h - z_m(U_m - u_{i+1/2,j}^h) = 0$$

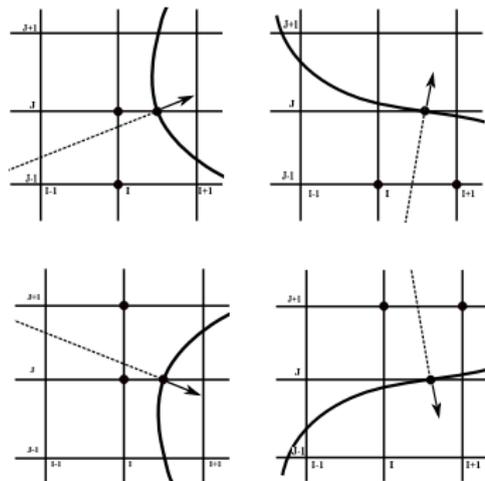


Figure: Les quatre cas possibles pour le choix de discrétisation de premier ordre du flux.

# Méthode numérique en proche

## Discrétisation de l'intégrale

discrétiser l'intégrale sur chaque électrode avec une formule de quadrature du premier ordre inspirée de Smereka donne:

$$\sum_{P \in E_m} \omega_P \zeta(U_m - u_P) = 0$$

Les poids  $\omega_p$  de la formule de quadrature qui sont affectés aux points de grille dans la méthode de Smereka sont ici affectés aux points limites les plus proches. Tous les coefficients  $\omega_p$  de la formule de quadrature sont positifs.

# Étude de la convergence

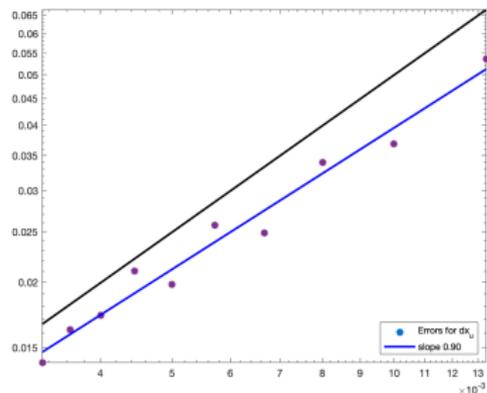
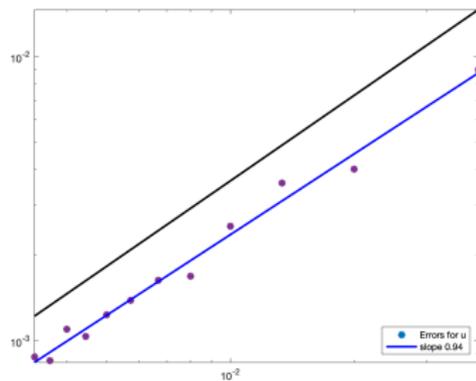


Figure: Solution de référence:  $u(x, y) = e^{(x^2+y^2)}$

- Fonctionnelle à minimiser:

$$F(\sigma) = \frac{1}{2} \|U(I, \sigma) - U_{mes}\|_{\mathbb{R}^M}^2 + \frac{\varepsilon}{2} \|\sigma - \sigma_*\|_{H^1(\Omega)}^2$$

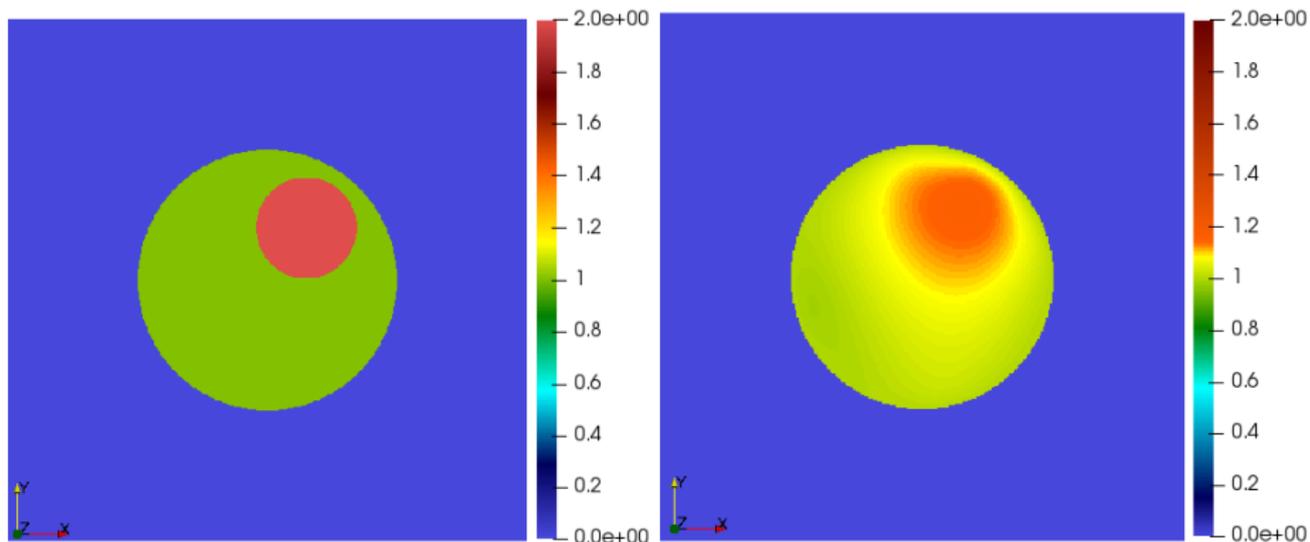
- Pour  $I \in \mathbb{R}_{\diamond}^M$  fixé,  $M : \sigma \mapsto (u(\sigma, I), U(\sigma, I))$  est Fréchet-différentiable

$$M(\sigma + \delta\sigma) = M(\sigma) + (\delta u, \delta U) + o(\delta\sigma).$$

- On définit  $\delta\sigma$  comme l'unique fonction de  $H_0^1(\Omega)$  telle que  $\forall \tilde{\sigma} \in H_0^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \nabla(\delta\sigma) \cdot \nabla \tilde{\sigma} + \delta\sigma \tilde{\sigma} = - \int_{\Omega} \mathbf{G} \cdot \nabla \tilde{\sigma} + f \tilde{\sigma}$$

## Reconstruction de conductivités: premiers résultats avec 8 électrodes



*Merci pour votre attention!!!*

# EIT: modélisation du problème direct

## "Smoothed electrode model": modèle régularisé

Trouver  $u \in H^1(\Omega)$  et  $U \in \mathbb{R}_{\diamond}^M$  tels que

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0 \text{ dans } \Omega \\ \sigma \partial_{\nu} u = \xi(U_m - u) \text{ sur } E_m, \\ \sigma \partial_{\nu} u = 0 \text{ on } \partial\Omega \setminus \bar{E}, \\ \int_{E_m} \sigma \partial_{\nu} u \, ds = I_m. \end{cases}$$

$\xi$  fonction  $\geq 0$  sur  $\partial\Omega$  vérifiant

- $\xi \equiv 0$  on  $\partial\Omega \setminus \bar{E}$
- $\xi \neq 0$  sur chaque  $E_m$

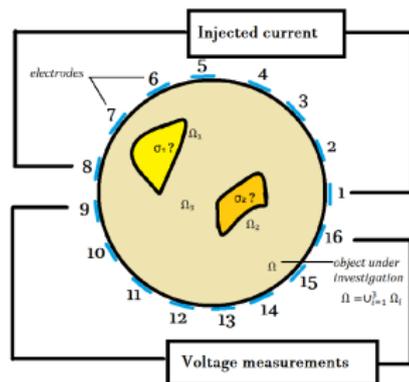


Figure: Image tirée de la thèse A. Velasco

## EIT: problème inverse

- Fonctionnelle à minimiser:

$$F(\sigma) = \frac{1}{2} \|U(I, \sigma) - U_{mes}\|_{\mathbb{R}^M}^2 + \frac{\varepsilon}{2} \|\sigma - \sigma_*\|_{H^1(\Omega)}^2$$

- Pour  $\delta\sigma \in H^1(\Omega)$  tel que  $\sigma + \delta\sigma > 0$  et  $t \geq 0$ :

$$F(\sigma + t\delta\sigma) \approx F(\sigma) + t(\delta U, U(I_{input}, \sigma) - U_{mes})_{\mathbb{R}^M} + t\varepsilon(\delta\sigma, \sigma - \sigma_0)_{H^1(\Omega)}$$

- On pose

$$(w, W) = (u, U)(U(I, \sigma) - U_{mes}, \sigma)$$

On a pour tout  $(v, V) \in H^1(\Omega) \times \mathbb{R}_{\diamond}^M$

$$\int_{\Omega} \sigma \nabla w \cdot \nabla v + \sum_m \int_{E_m} \xi(W_m - w)(V_m - v) = (U(I, \sigma) - U_{mes}) \cdot V$$

- En prenant  $(v, V) = (\delta u, \delta U)$  on obtient

$$(U(I, \sigma) - U_{mes}) \cdot \delta U = - \int_{\Omega} \delta\sigma \nabla u(\sigma, I) \cdot \nabla w$$

## EIT: problème inverse

- Fonctionnelle à minimiser:

$$F(\sigma) = \frac{1}{2} \|U(I, \sigma) - U_{mes}\|_{\mathbb{R}^M}^2 + \frac{\varepsilon}{2} \|\sigma - \sigma_*\|_{H^1(\Omega)}^2$$

- Pour  $\delta\sigma \in H^1(\Omega)$  tel que  $\sigma + \delta\sigma > 0$  et  $t \geq 0$ :

$$F(\sigma + t\delta\sigma) \approx F(\sigma) + t \int_{\Omega} \delta\sigma \underbrace{\left( \varepsilon(\sigma - \sigma_*) - \nabla u(\sigma, I) \cdot \nabla w \right)}_f + \underbrace{\nabla(\delta\sigma) \cdot \varepsilon \nabla(\sigma - \sigma_*)}_{\mathbf{G}}$$

- On définit  $\delta\sigma$  comme l'unique fonction de  $H_0^1(\Omega)$  telle que  $\forall \tilde{\sigma} \in H_0^1(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \nabla(\delta\sigma) \cdot \nabla \tilde{\sigma} + \delta\sigma \tilde{\sigma} = - \int_{\Omega} \mathbf{G} \cdot \nabla \tilde{\sigma} + f \tilde{\sigma}$$

- On obtient

$$\int_{\Omega} \delta\sigma f + \nabla(\delta\sigma) \cdot \mathbf{G} = -\|\delta\sigma\|_{H^1(\Omega)}^2 < 0$$